

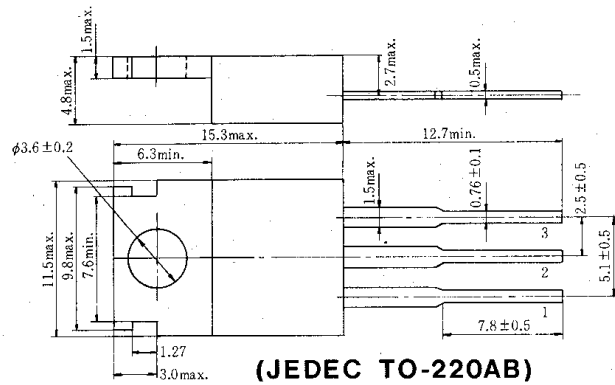
2SB690

シリコン PNP 三重拡散形

低周波電力増幅用
2SD726 とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SD726



1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

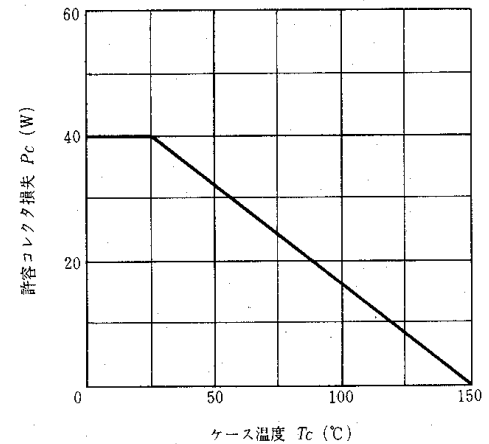
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項目 | Symbol | 2SB690 | Unit |
|-------------|----------------------|----------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧 | V_{CBO} | -100 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V_{CEO} | -80 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V_{EBO} | -5 | V |
| コレクタ電流 | I_C | -4 | A |
| せん頭コレクタ電流 | $i_{C(\text{peak})}$ | -8 | A |
| 許容コレクタ損失 | P_C^* | 40 | W |
| 接合部温度 | T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -45~+150 | $^\circ\text{C}$ |

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項目 | Symbol | Test Condition | min | typ | max | Unit |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| コレクタ・エミッタ破壊電圧 | $V_{(BR)CEO}$ | $I_C=-50\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$ | -80 | — | — | V |
| エミッタ・ベース破壊電圧 | $V_{(BR)EBO}$ | $I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$ | -5 | — | — | V |
| コレクタ遮断電流 | I_{CBO} | $V_{CB}=-80\text{V}$, $I_E=0$ | — | — | -0.1 | mA |
| 直流電流増幅率 | h_{FE1}^* | $V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$ | 60 | — | 200 | |
| 直流電流増幅率 | h_{FE2} | $V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-0.1\text{A}$ | 35 | — | — | |
| ベース・エミッタ電圧 | V_{BE} | $V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$ | — | — | -1.5 | V |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(\text{sat})}$ | $I_C=-2\text{A}$, $I_B=-0.2\text{A}$ | — | — | -2 | V |
| 利得帯域幅積 | f_T | $V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$ | — | 20 | — | MHz |
| コレクタ出力容量 | C_{ob} | $V_{CB}=-20\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$ | — | 75 | — | pF |

* 2SB690 は h_{FE1} の値により下記の様に 2 区分し、現品に表示してあります。

* The 2SB690 is grouped by h_{FE} as follows.

| Ⓑ | Ⓒ |
|--------|---------|
| 60~120 | 100~200 |